

**产品特性：**

工作频率 8.50~9.60GHz

饱和输出功率  $P_{sat} \geq 52\text{dBm}$ 功率增益  $\text{Gain} \geq 8\text{dB}$ 工作效率  $\eta \geq 36\%$ 端口匹配  $Z_{in}/Z_{out}=50\Omega$ **产品说明：**

HXN40096是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合

集成工艺，产品的典型工作频带为8.5~9.6GHz，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，

能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

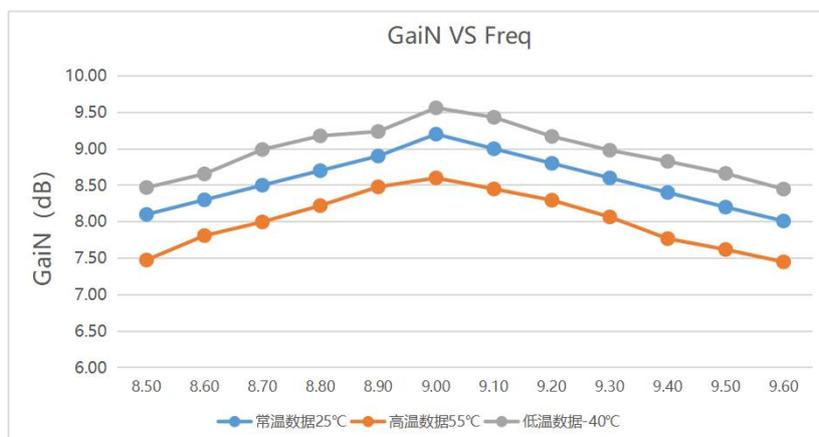
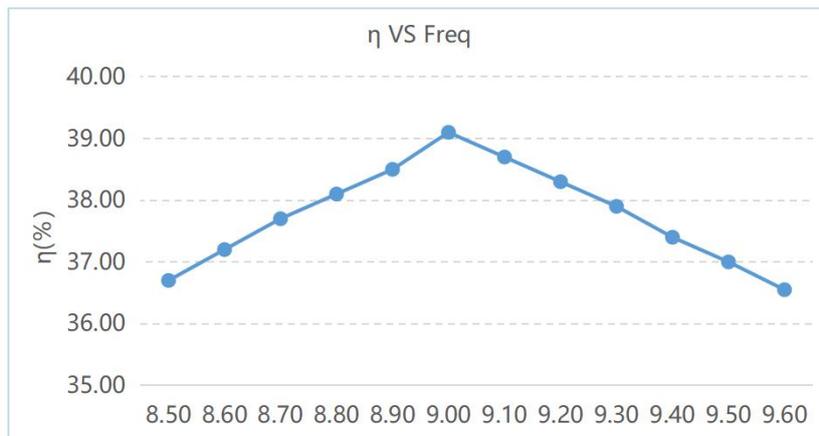
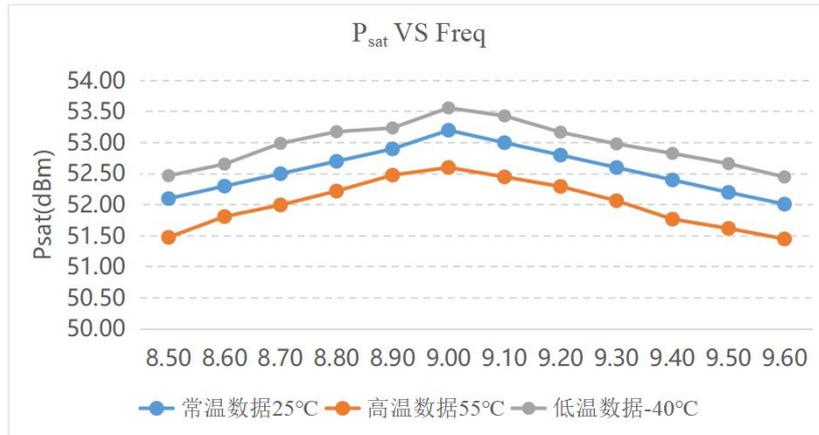
**最大额定值（TC=25°C，不推荐在此条件下工作）：**

| 参数   | 符号        | 值           | 单位 |
|------|-----------|-------------|----|
| 漏源电压 | $V_{DS}$  | 40          | V  |
| 栅源电压 | $V_{GS}$  | -5          | V  |
| 存储温度 | $T_{stg}$ | -65 to +150 | °C |
| 沟道温度 | $T_{ch}$  | 150         | °C |

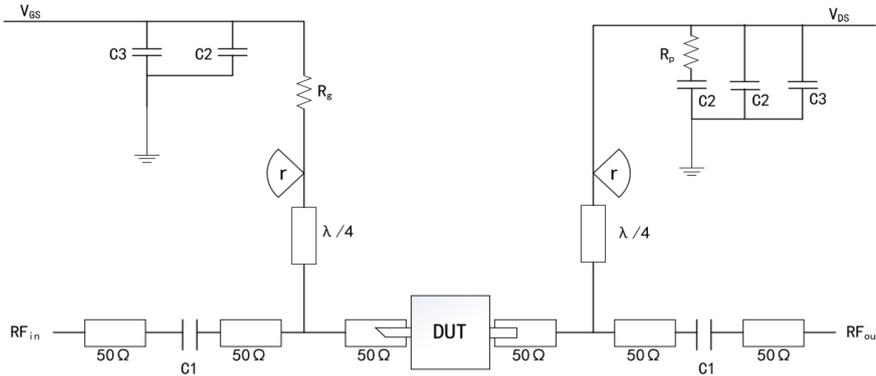
**微波电性能：**

| 参数     | 符号         | 测试条件                                 | 值    |      |     | 单位  |
|--------|------------|--------------------------------------|------|------|-----|-----|
|        |            |                                      | Min  | Typ  | Max |     |
| 漏极电流   | $I_{dsr}$  | $V_{DS}: 28\text{V}$                 | -    | 15.7 | -   | A   |
| 饱和输出功率 | $P_{sat}$  | 脉冲工作                                 | 52   | -    | -   | dBm |
| 功率增益   | $G_p$      | $T=1\text{ms}, \text{Duty}=10\%$     | 8    | -    | -   | dB  |
| 工作效率   | $\eta$     | $\text{Pin}: 44\text{dBm}$           | 36   | -    | -   | %   |
| 增益平坦度  | $\Delta G$ | $\text{Freq}: 8.5\sim 9.6\text{GHz}$ | -0.8 | -    | 0.8 | dB  |

典型曲线



**推荐应用电路：**



**DUT: 待测器件**

C1: 1pF

Rp: 51Ω

C2: 1000pF

Rg: 15Ω

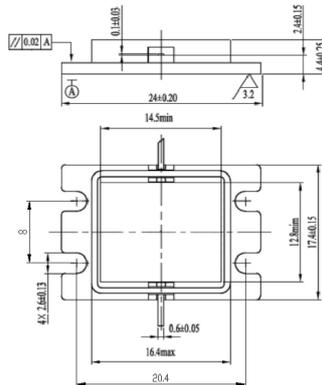
C3: 100uF

r半径≈3.5mm (Rogers5880, 20mil)

**防静电等级：**

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| ESD | Class III | 2000V |
|-----|-----------|-------|

**外观尺寸：**



**使用注意事项：**

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。